

## 6. 高耐圧デバイス測定装置



### 【仕様】

真空中にて

印可電圧：最大 3KV

印可電流：最大 20A

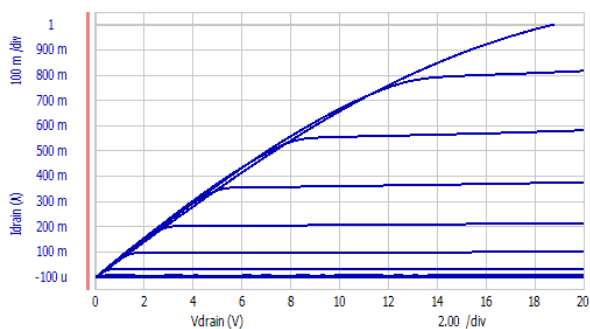
上記条件にて電流電圧特性および容量電圧特性等各種半導体パラメータを測定可能。

### 【特徴】

本装置はチップ 25mm $\square$ を真空チャンバー内で室温 $\sim$ 400 $^{\circ}$ Cの任意の温度に調整可能な高低温チャックを有します。ここに乗せられた試料を真空外から操作する 5 本の手動マニピュレーターを用い低ノイズ状態で電気特性を測定する為の装置です。ターボポンプ及びドライポンプにて真空を形成し、高耐圧測定を可能にしています。

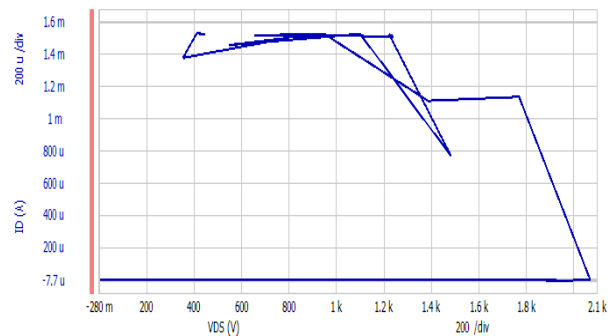
### 【計測例】 高耐圧 MOSFET の測定例

Ids-Vds 特性



Ids-Vds特性

ブレイクダウン電圧計測の例



ブレイクダウン電圧計測の例